

<http://physicsweb.org/article/news/6/10/3>

2002/10/02

تک خال در مدارها ی نامرئی

یک ماده ی نارسانا ی شفاف کشف شده، که تحت تابش فرابنفش رسانا می‌شود. انتظار می‌رود این کشف انقلابی در زمینه ی رشدیابنده ی فناوری ی مدارها ی نامرئی به پا کند. کاتسوز هایاشی [1] از شرکت فناوری و علوم ژاپن در کاوازاکی، و همکارانش می‌گویند مدارهای نامرئی ی چاپ شده روی فیلم نازکی از ماده پیشان را می‌شود در گستره ی وسیعی از ابزارها (از جمله صفحه ی کامپیوتر، ساعت، و تلفن همراه) به کاربرد [2].

رساناهای الکتریسیته ی شفاف، در بسیاری از زمینه‌ها ی اپتوالکترونیک امتیاز زیادی دارند. با مدارها ی ساخته شده با چنین رساناهایی می‌شود نمایشگرهای بلورمایع در دستگاههای اپتیکی را کنترل کرد، بی آن که به تراشه‌ها ی معمولی ی بخشکل نیاز باشد. اما بیشتر مواد شفاف، نارسانا ی الکتریسیته اند.

با ماده ای که گروه هایاشی بار آورده، یک گام به مدارها ی نامرئی نزدیکتر شده ایم. این ماده بر اساس کلسیم اکسید و آلمینیم اکسید است، و بلور آن شامل قفسهایی است که یک بار مثبت دارند. این پژوهشگران در یافتن وقتی این بلورها را در هیدروژن گرم کنند، یونها ی هیدرید (که یک بار منفی دارند) در این قفسهای دام می‌افتدند. پس از سردشدن، بلورها هنوز شفاف بودند، و آزمایش‌ها ی الکتریکی نشان می‌داد هنوز نارسانا بند.

اما این گروه دریافت پس از تابش نور فرابنفش به ماده، رساننده‌گی ی الکتریکی ی آن¹⁰⁹ بار زیاد می‌شود، و حتا پس از قطع تابش هم همین قدر می‌ماند. این پژوهشگران دریافتند با استفاده از این پدیده می‌شود مدارها ی شفاف ساخت: با تاباندن نور فرابنفش به ماده از درون یک ماسک، الکترودها و سیم‌ها ی الکتریکی درست می‌شود، در

حال ی که ناحیه‌ها ی تابش‌نديده نارسانا می‌مانند.

هایاشی و گروه[~]ش، برا ی تعیین منشی این پدیده ویژه‌گی‌ها ی الکتریکی ی این ماده در اثر گرم شدن و سرد شدن را سنجیدند. آن‌ها دریافتند رساننده‌گی، در دما ی 320° به شدت کم شد، اما با سرد کردن ماده به مقدار اولیه برگشت. اما در دما ی 550°، ماده هیدروژن به دام افتاده آش را آزاد کرد و حساسیت به نور[~]ش را به طور دائم از دست داد. از این‌جا هایاشی و هم‌کاران[~]ش به این فکر افتادند که ویژه‌گی‌ها ی الکتریکی ی این ماده به خاطر یون‌های هیدرید به دام افتاده آش است. این پژوهش‌گران می‌گویند نور فرابنفش باعث می‌شود این یون‌ها الکترون اضافی پیشان را بیرون بدهند، و این الکترون جذب قفس‌ها ی خالی ی بایار مثبت بلوغ شود. اما این ریاضی چنان ضعیف است که الکترون‌ها می‌توانند از یک قفس به یک قفس دیگر بپرنده. به این ترتیب دریای الکترون‌ی به وجود می‌آید، که بلوغ از طریق آن رسانا ی جریان می‌شود. گروه هایاشی معتقد است این ماده را می‌شود تنها در اپتوالکترونیک، بلکه برا ی ساختن حافظه‌ها ی اپتیکی ی چگال هم به کار برد. آن‌ها ضمناً حدس می‌زنند در مورد سایر فلز اکسیدها ی گروه اصلی هم ریافت مشابه ی کار کند.

[1] Katsuro Hayashi

[2] Nature 419 462